

共同研究体制図

- 課題名 「窒化物ハイブリッド成長膜による低損失スイッチング素子」
 ○代表者名（所属機関名） 「奥村 元（独立行政法人産業技術総合研究所）」
 ○提案機関名 「独立行政法人産業技術総合研究所」

ハイブリッドIII族窒化物ウエハーは、産総研サイドにある結晶成長装置（MBE及びMOCVD等）を用いて行う。この際、用いられる基板として、産総研サイドからSiC、旭化成サイドからAl₂O₃/Siの供給を適宜行う。

得られたエピタキシャルウエハーを用いてデバイスチップの作製試験を、旭化成サイドにおいて整備したプロセス装置（エッチング装置、蒸着装置等）を用いて行う。

一方、エピタキシャルウエハー、及び作製された低損失デバイスチップの特性評価を産総研サイドで行う。（半導体パラメータアナライザ、X線トポ等）

旭化成サイドにおいては、事業化に向けたウエハーの大口径均一化、信頼性試験等を行う。（信頼性試験器）

